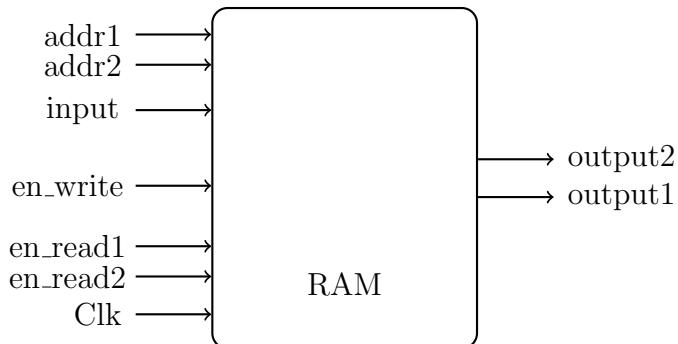


RAM (Datenspeicher)

Ihre Aufgabe ist es, das Verhalten einer Entity namens „RAM“ zu programmieren. Die Entity ist in der angehängten Datei „RAM.vhdl“ deklariert und hat folgende Eigenschaften:

- Eingang: Clk vom Typ std_logic
- Eingang: en_read1 vom Typ std_logic
- Eingang: en_read2 vom Typ std_logic
- Eingang: en_write vom Typ std_logic
- Eingang: input vom Typ std_logic_vector
- Eingang: addr1 vom Typ std_logic_vector
- Eingang: addr2 vom Typ std_logic_vector
- Ausgang: output1 vom Typ std_logic_vector
- Ausgang: output2 vom Typ std_logic_vector



Verändern sie die Datei „RAM.vhdl“ nicht!

Die Entity „RAM“ soll sich wie folgt verhalten:

Die Ausgänge der Entity und der Inhalt des RAMs können sich nur bei einer steigenden Flanke des Taktsignals verändern. Der anfängliche Inhalt des Speichers ist Null.

Die Adresse einer Speicherposition, an die Daten geschrieben oder von der Daten ausgelesen werden, wird durch die Adresseingänge festgelegt. Wenn die Steuereingänge für einen Lesebefehl („read enable“) oder einen Schreibbefehl („write enable“) aktiv sind ('1'), dann soll der jeweilige Befehl bei steigender Flanke des Taktsignals ausgeführt werden.

- Die erste Adresse ist die Adresse für den ersten Lesebefehl (aktiviert durch en_read1) und den Schreibbefehl (aktiviert durch en_write). Die zweite Adresse ist die Adresse für den zweiten Lesebefehl (aktiviert durch en_read2) und hat keine zusätzliche Funktion.
- Wenn nur en_read1 '1' ist, dann wird der Inhalt von addr1 gelesen und am Ausgang output1 ausgegeben.
- Wenn nur en_read2 '1' ist, dann wird der Inhalt von addr2 gelesen und am Ausgang output2 ausgegeben.
- Wenn nur en_write '1' ist, dann wird der Eingang an die Adresse addr1 geschrieben.
- Lesen von addr2 und Schreiben auf addr1 kann gleichzeitig ausgeführt werden, wenn addr1 sich von addr2 unterscheidet und addr1 sich von der nächsthöheren Adresse von addr2 unterscheidet.
- Zwei Lesebefehle können gleichzeitig ausgeführt werden.
- Beachten Sie, dass sich in allen anderen Fällen der Inhalt des RAMs nicht verändern darf und der Ausgang hochohmig (high impedance, 'Z') sein soll.
- Wenn der Speicher nicht ausgelesen wird, soll der zugehörige Ausgang hochohmig (high impedance, 'Z') sein.

Die Länge der Adressen beträgt 7 Bit, die Länge der Eingangsdaten 18 Bit, die Länge der Ausgangsdaten 36 Bit und die Länge der einzelnen Speicherzellen 18 Bit.

- Wenn en_write aktiv ist, dann sollen die Eingangsdaten an die angegebene Adresse geschrieben werden. Die Länge der Eingangsdaten und die Länge der Speicherzellen sind gleich.
- Die Länge der Ausgangsdaten ist doppelt so groß wie die Länge der Speicherzellen. Daher sollen die Daten von der angegebenen Adresse gelesen und in die untere Hälfte der Ausgangsdaten gesetzt werden. In die obere Hälfte der Ausgangsdaten sollen die Daten von der nächsthöheren Adresse gesetzt werden. Wir nehmen dabei an, dass die letztmögliche Speicheradresse nie für einen Lesebefehl verwendet wird.

Programmieren Sie dieses Verhalten in der angehängten Datei „RAM_beh.vhdl“.

Um Ihre Lösung abzugeben, senden Sie ein E-Mail mit dem Betreff „Result Task 5“ und Ihrer Datei „RAM_beh.vhdl“ an vhdl-mc+e384@tuwien.ac.at.

Viel Erfolg und möge die Macht mit Ihnen sein.